(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月25日(25.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/197877 A1

(51) 国際特許分類:
C09D 201/00 (2006.01) *C09J 5/00* (2006.01)
B32B 7/06 (2019.01) *C09J 183/05* (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01) *C09J 183/07* (2006.01)
C09D 5/00 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/010327

(22) 国際出願日： 2025年3月18日(18.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-043603 2024年3月19日(19.03.2024) JP

(71) 出願人：日産化学株式会社(**NISSAN CHEMICAL CORPORATION**) [JP/JP]；〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 (JP).

(72) 発明者：臼井 友輝(**USUI Yuki**)；〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP). 奥野 貴久(**OKUNO Takahisa**)；〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP). 岸岡 高広(**KISHIOKA Takahiro**)；〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP).

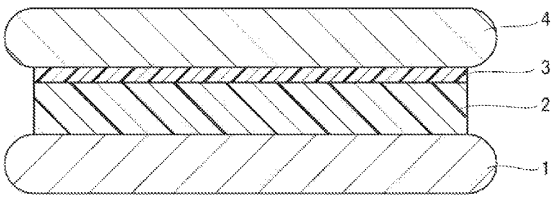
(74) 代理人：高岡 亮一，外(**TAKAOKA Ryoichi** et al.)；〒1710021 東京都豊島区西池袋５－４－７ 池袋トーセイビル５階 高岡ＩＰ特許事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能)：AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,

(54) **Title:** COMPOSITION FOR FORMING PRIMER FILM, LAMINATE, METHOD FOR PRODUCING LAMINATE, AND METHOD FOR PRODUCING PROCESSED SEMICONDUCTOR SUBSTRATE OR ELECTRONIC DEVICE SUBSTRATE

(54) 発明の名称：プライマー皮膜形成用組成物、積層体、積層体の製造方法、及び加工された半導体基板又は電子デバイス基板の製造方法

[図1]



(57) **Abstract:** The present invention provides, for example, a laminate which comprises a support substrate, a semiconductor substrate or an electronic device substrate, and an adhesive layer that is provided between the semiconductor substrate or the electronic device substrate and the support substrate, and with which it is possible to control the separation interface when a semiconductor wafer is separated from the support substrate. This laminate comprises a support substrate, a semiconductor substrate or an electronic device substrate, and an adhesive layer that is provided between the semiconductor substrate or the electronic device substrate and the support substrate, wherein: a primer film is formed on a substrate surface of one of the semiconductor substrate, the electronic device substrate, and the support substrate; and the primer film is formed of a composition for forming a primer film for enhancing the adhesion between a substrate and an adhesive layer that is formed of an adhesive composition which contains an adhesive component that is cured by a hydrosilylation reaction, the composition for forming a primer film containing a component that contributes to the hydrosilylation reaction.

WO 2025/197877 A1

[続葉有]

HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：支持基板と、半導体基板又は電子デバイス基板と、前記半導体基板又は前記電子デバイス基板と、前記支持基板との間に設けられた、接着剤層とを有する積層体において、 支持基板から半導体ウエハーを剥がす際に剥離界面をコントロールできる積層体等を提供する。 支持基板と、半導体基板又は電子デバイス基板と、前記半導体基板又は前記電子デバイス基板と、前記支持基板との間に設けられた、接着剤層とを有し、 前記半導体基板又は前記電子デバイス基板、及び前記支持基板のいずれかの基板表面にプライマー皮膜が形成されており、 前記プライマー皮膜は、ヒドロシリル化反応によって硬化する接着剤成分を含有する接着剤組成物から形成される接着剤層と基板との接着力を高めるためのプライマー皮膜形成用組成物であって、前記ヒドロシリル化反応に寄与する成分を含有するプライマー皮膜形成用組成物から形成されたプライマー皮膜である、積層体である。